Ж. нано- електрон. фіз./ J. Nano- Electron. Phys. 2010. – Т.2, №3. – С.32-39

PACS number: 07.57. – c

УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА

А.В. Стрижаченко, А.А. Звягинцев, С.Н. Шульга, В.В. Чижов

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Пл. Свободы 4, 61077, Харьков, Украина E-mail: A.Strizhachenko@mail.ru

Описаны оригинальные узкополосные малогабаритные фильтры на основе высоко-добротного волноводно-диэлектрического резонатора с анизотропными матери-алами. Разработанные фильтры удовлетворяют противоречивым требованиям: обеспечивают узкую полосу частот (0,05 \div 0,1 % от центральной частоты f_0) в сочетании с низкими начальными потерями $\alpha_0 \leq 1$ дБ.

Ключевые слова: ВОЛНОВОДНО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР, ФИЛЬТР, АНИЗОТРОПНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК.

(Получено 09.07.2010, в отредактированной форме – 18.09.2010)

1. ВВЕДЕНИЕ

Для решения задачи электромагнитной совместимости и уплотнения информационных каналов систем спутниковой связи и телевидения в микроволновом диапазоне используются узкополосные фильтры. Они должны обеспечивать сочетание узких полос пропускания и высоких заграждений с малыми потерями СВЧ сигнала, обладать стабильностью электрических характеристик в широком интервале температур. Основные применения узкополосные фильтры находят в СВЧ генераторах с малым уровнем шумов, преселекторах СВЧ приемников, измерительной аппаратуре.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая статья посвящена разработке узкополосных малогабаритных CBЧ- фильтров на основе высокодобротного волноводно-диэлектрического резонатора (ВДВДР). Фильтры представляют собой отрезок прямоугольного волновода с фланцами, который содержит один или несколько диэлектрических вкладышей, полностью заполняющих резонатор вдоль узкой стенки волновода и частично вдоль широкой (рис. 1 а, б). Такие фильтры [1] удовлетворяют противоречивым требованиям:

- 1. Обеспечивает узкую полосу частот (0,05 ÷ 0,1 % от центральной частоты f_0) в сочетании с низкими начальными потерями α_0 ($\alpha_0 \le 1$ дБ). Это возможно, благодаря использованию резонаторов с собственной добротностью не менее (15 ÷ 20)·10³ ед., которая достигается путем использования монокристаллических материалов с низкими диэлектрическими потерями.
- 2. Поворот резонатора на 90° относительно Н-плоскости волноводного тракта позволяет существенно повысить добротность по сравнению с



УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА 33

обычными волноводно-диэлектрическими резонаторами (ВДР) благодаря тому, что токи проводимости, протекавшие ранее в окружавшем диэлектрик металле, в значительной степени оказались замененными токами смещения, что позволило уменьшить среднюю мощность потерь в металлических стенках резонатора.



Рис. 1 – Узкополосные СВЧ фильтры: однозвенный(а), двухзвенный (б)

Изготовленные фильтры обладают следующими характеристиками:

центральная частота f ₀ , МГц	$9500\div10000$
полоса пропускания (по уровню 1 дБ), МГц	8 ÷ 10
начальные потери α_0 , дБ	≤ 1
подавление в полосе заграждения:	
- для двухзвенного фильтра, дБ, не менее	20
- для трехзвенного фильтра, дБ, не менее	30
масса, г	pprox 150
используемый диэлектрик	лейкосапфир

Кроме того, в работе исследован вопрос технологичности при серийном изготовлении таких фильтров: влияния состояния поверхностей волновода и диэлектрического вкладыша, выбора материала конструкции, а также допусков при изготовлении и настройки.

Рассмотрим влияние материала на основные параметры высокодобротного резонатора. Сравнивались ВДВДР, выполненные на основе волноводных секций, изготовленных из латуни и меди. Волноводные секции имели одинаковую длину (L = 50 мм), в которые помещался один и тот же лейкосапфировый вкладыш. Таким образом, ВДВДР находились в одинаковых условиях. В таблице 1 приведены численные данные для двух резонансов в исследуемом частотном диапазоне. Из приведенных данных видно, что материал волноводной секции оказывает существенное влияние на характеристики резонатора. Наиболее подходящими материалами является медь и серебро. Либо изготавливать волноводные секции из других материалов, но с посеребренной внутренней поверхностью и фланцами.

Параметр	латунная секция $\sigma = 1.57 \cdot 10^{-7}$ сим/м [2]	медная секция $\sigma = 5.97 \cdot 10^{-7}$ сим/м [2]
$egin{array}{c} a/\lambda & & \ lpha_0,\ { m dB} & & \ Q_{ m {\it H}} & & \ Q_0 & & \ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.384 \\ 1.84 \\ 2560 \\ 13500 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.384 \\ 1.45 \\ 2900 \\ 19300 \end{array}$
$egin{array}{c} a/\lambda & \ lpha_0,\ { m gB} & \ Q_{ m H} & \ Q_0 & \ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.306 \\ 5.3 \\ 4300 \\ 9400 \end{array}$	$0.384 \\ 5.0 \\ 5800 \\ 13300$

Таблица 1 – Влияние материала секции на параметры ВДВДР

Для исследования влияния материала диэлектрического вкладыша было изготовлено три вкладыша с одинаковыми геометрическими размерами и проведены измерения в одной и той же измерительной секции, изготовленной из меди. Вкладыши были изготовлены из фторопласта, кристаллического кварца и лейкосапфира, электрические параметры которых приведены [3]. В таблице 2 приведены результаты, которые показывают явную зависимость величины добротности от материала диэлектрического вкладыша. Следовательно, необходимо выбирать материал с минимальным значением тангенс угла диэлектрических потерь.

Таблица 2 – Влияние материала диэлектрического вкладыша на параметры ВДВДР

Параметр	вкладыш из	вкладыш из	вкладыш из
	фторопласта	кварца	лейкосапфира
a/λ	0.348	0.305	0.384
α ₀ , дБ	11.1	5.2	1.32
$Q_{\scriptscriptstyle \mathcal{H}}$	3.660	4.240	3050
Q_0	5090	9740	21600

Для изучения вопроса влияния состояния поверхности ВДВДР на его параметры измерения проводились для ВДВДР на основе волноводной секции, выполненной из стандартной волноводной трубы без предварительной обработки ее внутренней поверхности и сравнение с параметрами ВДВДР, измеренными после полировки внутренней поверхности волновода (см. таблицу 3).

Таблица 3 – Влияние состояния металлической поверхности на параметры ВДВДР

Параметр	ВДВДР на основе неполированной секции	ВДВДР на основе полированной секции
a/λ	0.384	0.384
α ₀ , дБ	6.6	6.6
Q_{μ}	6680	6860
Q_0	12550	13023

Результаты, приведенные в таблице 3, позволяют сделать вывод о несущественном влиянии состояния внутренней поверхности волновода на величину собственной добротности ВДВДР. По той же причине отпадает необходимость полировки поверхности диэлектрического вкладыша, что повышает технологичность изготовления фильтров на основе ВДВДР.

Исследовался вопрос о влиянии допусков при изготовлении и сборке на параметры ВДВДР. Основная сборка фильтра заключена в правильной установке диэлектрического вкладыша в волноводной секции. Оптимальным положением вкладыша, с точки зрения получения наиболее высоких показателей фильтра, является симметричное расположение диэлектрического вкладыша по отношению к боковым стенкам волновода и фланцам. Сдвиг вкладыша (ΔL , мм) проводился относительно его симметричного положения вдоль длины резонатора L (относительно фланцев). Выставление вклалыша проволилось с помошью микрометра часового типа с точностью до 0.1 мм. Сдвиг производился на первом миллиметре через 0.2 мм, далее через 0.5 мм, сохраняя при этом симметричное положение образца по отношению к боковым стенкам секции. Контролировалась резонансная частота (рис. 2, кривая 1), ширина полосы пропускания на уровне 3 дБ (рис. 2, кривая 2), потери, вносимые ВДВДР на резонансной частоте (рис. 3, кривая 1). Кривая 2 на рис. 3 соответствует рассчитанной нагруженной добротности согласно соотношения [4]:



 $Q_{\scriptscriptstyle H} = rac{f_0}{2\Delta f} \cdot (10^{rac{lpha - lpha_0}{10}} - 1)^{1/2}$,

Рис. 2 – Зависимость относительной резонансной частоты a/λ и ширины полосы пропускания Δf от сдвига образца ΔL вдоль продольной оси секции относительно симметричного положения

36 А.В. СТРИЖАЧЕНКО, А.А. ЗВЯГИНЦЕВ, С.Н. ШУЛЬГА, В.В. ЧИЖОВ

где α_0 и α – затухание на резонансной частоте и при отстройке от резонансной частоты соответственно, выраженные в дБ. Из приведенных графиков видно, что сдвиг образца из симметричного положения вдоль продольной оси резонатора на расстояние до ± 1 мм заметных изменений параметров резонатора не вызывает. Дальнейший сдвиг диэлектрического вкладыша вызывает значительное расширение полосы частот: порядка 0.7 МГц на 1 мм сдвига и увеличение потерь α порядка 0,5 дБ на 1 мм сдвига. Значительный уход резонансной частоты возникает при сдвиге на 4 мм и более. Отсюда можно сделать вывод, что допуск на неточность установки образца может быть ± 1 мм.

Исследовался сдвиг относительно симметричного вкладыша положения вдоль широкой стенки резонатора (размера b). Измерение и контроль параметров проводился аналогично описанному в предыдущем случае. Выставление образца производилось с помощью калиброванной оправки, толщина которой изменялась по 0,2 мм на первом миллиметре сдвига и далее по 0.5 мм. Калибровка толщины проводилась с точностью ± 0,02 мм. На графике (рис. 4) нанесены кривые изменения относительной резонансной длины волны (a/λ) (кривая 1) и ширины полосы пропускания на уровне 3 дБ (кривая 2) от величины сдвига вкладыша ΔL . На графике (рис. 5) нанесены кривые изменения потерь ВДВДР на резонансной частоте (кривая 2), а также значения нагруженной и собственной добротностей резонатора (кривые 3 и 1 соответственно). Видно, что в случае сдвига лейкосапфирового образца из его оптимального положения к боковым стенкам волновода, сохраняя при этом симметрию по отношению к фланцам, изменение электрических параметров ВДВДР



Рис. 3 – Зависимость изменения затухания α и добротности Q от сдвига образца ΔL вдоль продольной оси секции относительно симметричного положення



Рис. 4 – Зависимость относительной резонансной частоты a/λ и ширины полосы пропускания Δf от сдвига образца ΔL вдоль стенок волновода q_{0} . Пб $Q \times 10^{-3}$



Рис. 5 – Зависимость α (кривая 2), Q_0 (1) и $Q_{\rm H}$ (3) от сдвига образца ΔL вдоль стенок волновода относительно симметричного положения

значительно меньше, чем в предыдущем случае. Изменения резонансной частоты, ширины полосы пропускания на уровне 3 дБ и нагруженной добротности несущественны до величины сдвига $\Delta L = 4,5$ мм от симметричного положения. Наибольшее увеличение потерь ВДВДР на резонансной частоте (приблизительно 0.35 дБ) при сдвиге на $\Delta L = 4,5$ мм, вызывает уменьшение собственной добротности резонатора на величину $Q_0 \approx 3000$ ед. Это говорит о слабом влиянии сдвига лейкосапфирового вкладыша по направлению к боковым стенкам волновода.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описаны оригинальные узкополосные малогабаритные фильтры на основе высокодобротного волноводно-диэлектрического резонатора с анизотропными материалами. Разработанные фильтры удовлетворяют противоречивым требованиям: обеспечивают узкую полосу частот (0,05 \div 0,1 % от центральной частоты f_0) в сочетании с низкими начальными потерями $\alpha_0 \leq 1$ дБ. Это возможно, благодаря использованию резонаторов с собственной добротностью не менее ($15 \div 20$)· 10^3 ед., которая достигается путем использования монокристаллических материалов с низкими диэлектрическими потерями. Поворот резонатора на 90° относительно H-плоскости волноводного тракта позволяет существенно повысить добротность по сравнению с обычными ВДР. Проведенные в работе исследования позволяют сделать вывод, что разработанные фильтры технологичны при серийном изготовлении.

NARROW-BAND MICROWAVE FILTERS

A.V. Strizhachenko, A.A. Zvyagintsev, S.N. Shul'ga, V.V. Chizhov

V.N. Karazin Kharkiv National University, 4, Svobody Sq., 61077, Kharkiv, Ukraine E-mail: A.Strizhachenko@mail.ru.

Original design of the narrow-band compact filters based on the high-quality waveguide-dielectric resonator with anisotropic materials has been presented in this work. Designed filters satisfy the contradictory requirements: they provide the narrow frequency band $(0,05 \div 0,1\%)$ of the main frequency f_0 and the low initial losses $\alpha_0 \leq 1 \ dB$.

Keywords: WAVEGUIDE-DIELECTRIC RESONATOR, FILTER, ANISOTROPIC DIELECTRIC.

ВУЗЬКОСМУГОВІ ФІЛЬТРИ МИКРОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНА

А.В. Стрижаченко, А.А. Звягінцев, С.Н. Шульга, В.В. Чижов

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Пл. Свободи 4, 61077, Харків, Україна E-mail: A.Strizhachenko@mail.ru

УЗКОПОЛОСНЫЕ ФИЛЬТРЫ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА 39

Описано оригінальні вузькосмугові малогабаритні фільтри на основі високодобротного хвилеводно-діелектричного резонатора із анізотропними матеріалами. Розроблені фільтри задовольняють суперечним вимогам: забезпечують вузьку смугу частот (0.05 ÷ 0.1 % від центральної частоти f_0) в сполученні з низькими початковими втратами $\alpha_0 \leq 1$ дБ.

Ключові слова: ХВИЛЕВОДНО-ДИЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАТОР, ФІЛЬТР, АНІЗОТРОПНИЙ ДІЕЛЕКТРИК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

- 1. A. Zvyagintsev, A. Strizhachenko, V. Chizhov, V. Popov, Proceedings of International Conference on Mathematical Method in Electromagnetic (MMET-98), 54 (URSI: Kharkov: 1998).
- 2. А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов, Справочник по элементам волноводной техники (М.:Сов.радио: 1967).
- 3. М.Н. Бергер, Б.Ю. Капилевич, Прямоугольные волноводы с диэлектриками (М.: Сов. радио 1973).
- 4. Ф. Тишер, Техника измерений на сверхвысоких частотах. Справочное руководство (Пер. с немецкого) (М.: Физматгиз: 1963).